

**Сведения о ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении
субсидии от 14 октября 2015 года № 14.607.21.0116**

На этапе №3

Руководитель проекта к.ф.-м.н. МЛ.Занавескин

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.607.21.0116 от 14 октября 2015 года Минобрнауки России уникальный идентификатор ПНИ RFMEFI160715X0116 в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №3 «Изготовление библиотек стандартных элементов и экстракция параметров эквивалентных схем» в период с 01 июля по 31 декабря 2016 года выполнялись следующие работы.

Работы по плану-графику исполнения обязательств, расходы на которые возмещаются за счет средств субсидии:

1. Разработка рабочей конструкторской и технологической документации изготовления гетероструктур AlGaN с двойным электронным ограничением на подложках SiC с невплавными омическими контактами: без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN.
2. Изготовление гетероструктуры AlGaN с двойным электронным ограничением на подложках SiC с невплавными омическими контактами: без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN.
3. Проведение испытаний гетероструктур без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN с невплавными омическими контактами на подложках SiC на соответствие требованиям п.5.2 ТЗ согласно программе и методикам пункта 2.18 Плана-графика исполнения обязательств.

При этом были получены следующие результаты:

1. Разработана рабочая конструкторская и технологическая документации изготовления гетероструктур AlGaN с двойным электронным ограничением на подложках SiC с неплавными омическими контактами: без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN.
2. Изготовлены гетероструктуры AlGaN с двойным электронным ограничением на подложках SiC с неплавными омическими контактами: без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN.
3. Проведены испытания гетероструктур без пассивирующих слоев, со слоем SiNx, со слоем GaN с неплавными омическими контактами на подложках SiC на соответствие требованиям п.5.2 ТЗ согласно программе и методикам пункта 2.18 Плана-графика исполнения обязательств.

Все полученные результаты соответствуют требованиям ТЗ.

На этапе 3 по результатам проведенных работ было защищено ноу-хау «Способ сохранения электрофизических параметров двумерного электронного газа в процессе изготовления монолитных интегральных схем на основе нитридных гетероструктур».

На этапе 3 роль индустриального партнера заключалась в финансировании проекта в необходимом объеме - проведение работ по пунктам плана-графика исполнения обязательств:

- 3.25 Проведение контроля базовых технологических процессов согласно программам и методикам пункта 2.17 Плана-графика исполнения обязательств.

Все задачи этапа №3 работ выполнены в полном объеме и в соответствии с Планом-графиком исполнения обязательств и Техническим заданием Соглашения №14.607.21.0116 о предоставлении субсидий от 14/10/2015.